



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HS733

对应国外型号
2SA733

主要用途

作音频放大器的驱动级和低速开关。(与 HS945 互补)

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散.....	250mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-60V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-50V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-150mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-60			V	$I_C=-100 \mu\text{A}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-50			V	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10 \mu\text{A}, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{CB}=-60\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	70	700			$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.3	V	$I_C=-100\text{mA}, I_B=-10\text{mA}$
$V_{BE(ON)}$	基极—发射极导通电压	-0.5		-0.8	V	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}$
f_T	特征频率	50	180		MHz	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=10\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		2.8		pF	$V_{CB}=6\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$
NF	噪声系数		6.0	20	dB	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-0.3\text{mA}, f=100\text{Hz}, R_S=10$

分档及其标志

O

Y

GR

BL

70—140

120—240

200—400

350—700